



APDI-80P-RM

InGaAs ФОТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

InGaAs лавинный фотодиодный модуль APDI-80P-RM с предельной частотой 1ГГц оптически согласован с многомодовым волокном и предназначен для приема малых оптических сигналов в спектральном диапазоне 800 - 1650нм в аппаратуре оптической рефлектометрии.

Предельные значения

Обратный ток , I_R	0.5мА
Прямой ток , I_f	10мА
Рабочая температура, T_c :	-40 ÷ +60°C
Температура хранения, T_{stg}	-40 ÷ +60°C

Электрические / оптические параметры (ОМ, 25°C)

Параметр		Мин.	Тип.	Макс.	Един.	Условия
Чувствительность	S_λ	0.8	1.0		А/Вт	$M=1, \lambda=1550\text{нм}$
Коэффициент умножения	M	30	50			$\lambda=1550\text{нм}, V_R=V(I_D=1\text{мкА})$
Температурный коэффициент напряжения лавины	δ		0.2		%/°C	
Напряжение лавины	V_B		70	100	В	
Темновой ток	I_D		5	20	нА	$V_R=0.9V_{BR}$
Емкость	C_t		0.5	0.75	пФ	$V_R=0.9V_{BR}, F=1\text{МГц}$
Предельная частота	f_c	1			ГГц	$M=10, \lambda=1550\text{нм}, R_L=50\Omega, -3\text{дБ}$

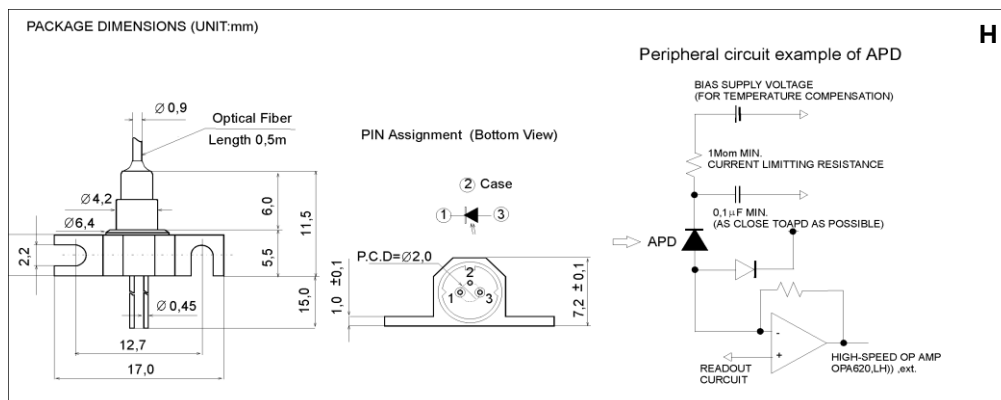
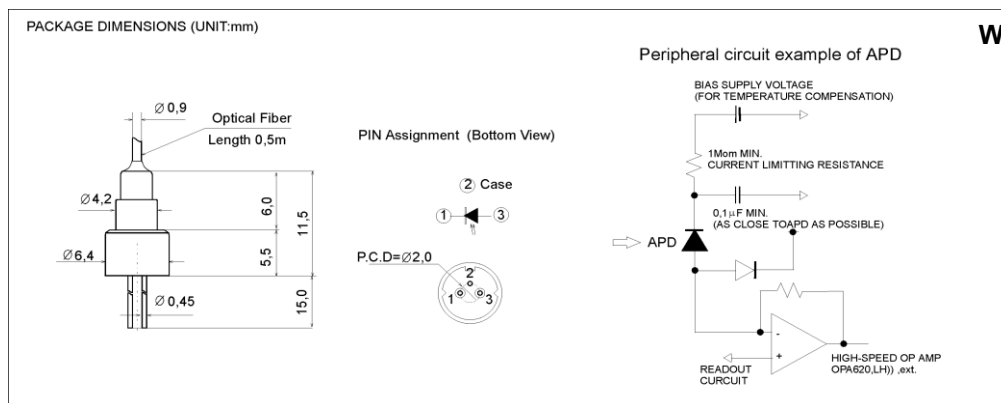
$\delta = [V_{BR}(25^\circ\text{C} + \Delta T^\circ\text{C}) - V_{BR}(25^\circ\text{C})] / [\Delta T^\circ\text{C} - V_{BR}(25^\circ\text{C})]$

Информация для заказа

APDI-80P-RM-X-MM(50)-X

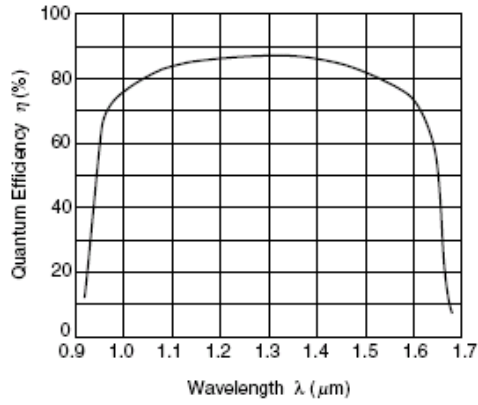
Тип коннектора: FC/PC, N – без коннектора

Тип корпуса: W, H

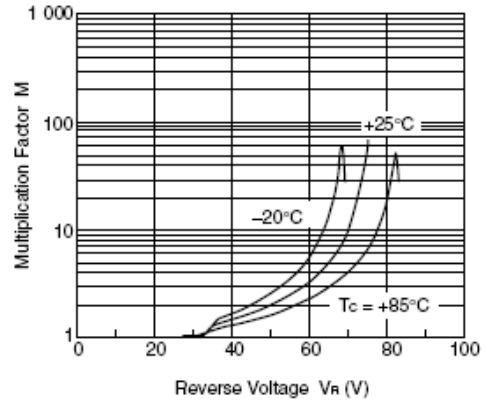


Примечание: При работе с модулем необходимо обеспечить защиту от статического электричества
Предпочтительная длина волокна – 0.5 м

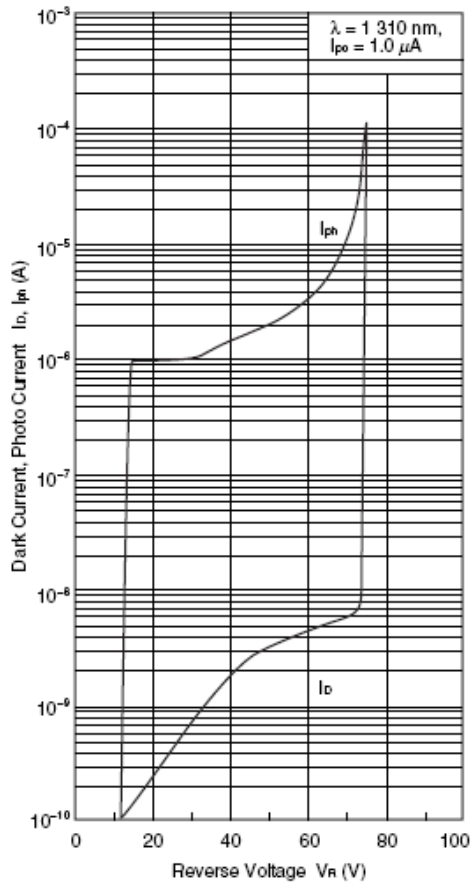
WAVELENGTH DEPENDENCE OF QUANTUM EFFICIENCY



MULTIPLICATION FACTOR vs. REVERSE VOLTAGE



DARK CURRENT AND PHOTO CURRENT vs. REVERSE VOLTAGE



DARK CURRENT vs. REVERSE VOLTAGE

